Stato analisi cristalli+APD a LNF

- Highlights B2GM di ottobre
- Resa di luce dei cristalli di Belle evoluzione temporale
- Studi con CsI(TI)+APD+amplificatore a transimpedenza

Highlights dal B2GM di ottobre

Presentazione di M. Piccolo (<u>https://goo.gl/kLgAoj</u>)



Guadagno degli APD e numero di primari

• Dal confronto del segnale di pin e APD nello stesso cristallo di CsI(TI)



With respect to the traditional methods at the operational voltages, gains are 30-40% lower when measured in this direct way. At higher gains the discrepancy grows much bigger.

• Misurato il guadagno *di APD e preamp*, il numero di primari risulta:

CsI(Tl) $\rightarrow \sim 750$ p.e./MeV/device ± (5%+10%) CsI $\rightarrow \sim 15$ p.e./MeV/device ± (5%+10%)

 Risultato consistente con APD letti con CR-110 e amplificatore a transimpedenza

9 novembre 2016

G. Finocchiaro

Excess noise factor

۲

• Dal confronto di ampiezza e risoluzione in CsI+APD





Summary and conclusions

We measured with a light tag method both LAAPD gain and excess noise factor.

The gain values we obtain are, in the voltage range of operations, lower than the ones provided by traditional DC measurement.

Values for excess noise ratios are between 3 and 4. ENE and relative energy resolution are respectively:

CsI(Tl) no source 1 MeV .025 errors O(10%) CsI(Tl) with source 2 MeV .025 " CsI no source 1.6 MeV .075 " CsI with source 1.9 MeV .075 " More data and results in a forthcoming Belle-2 note.

Storia dei cristalli di Belle

- Per riconciliare i nostri risultati sul numero di primari in CsI(TI) con quelli di Kuzmin, abbiamo riesaminato i dati presi con i cristalli in nostro possesso
- I cristalli irraggiati alla Casaccia sono il 311017 (250Gy) e il 327017 (750Gy)

S/N	Faccia grande (I x h)	Faccia piccola (I x h)	Spessore medio (cm)	Commenti	dE/dx media
311017	8.1 x 7.4	7.3 x 5.7	6.55	250Gy Run 40-41-42	39.3
319065	6.1 x 5.9	5.6 x 5.6	5.75	Reference Run 1-39	34.5
327017	7.9 x 6.8	7.1 x 5.6	6.20	750Gy Dal run 40 in poi	37.2

- Abbiamo usato i dati raccolti prima dell'irraggiamento per confrontare le rese in luce prima e dopo l'irraggiamento e durante i quasi 2 anni trascorsi dopo i dati raccolti alla Casaccia
- I dati raccolti nell'ultimo anno (durante i runs presi nel laboratorio sorgenti ad alta attività) mostrano una differenza notevole nella resa in luce tra il cristallo di riferimento e i due cristalli irraggiati

Dati pre-irraggiamento

- Il primo errore è sulla determinazione del valore più probabile dell'ampiezza, il • secondo sulla calibrazione del guadagno dei preamp
 - stimati in maniera conservativa -
 - Per il Cristallo 32017 errore più grande in quanto l'ampiezza vera e' estrapolata: la costante di tempo dell'uscita del preamp era attorno al microsecondo e ho dovuto correggere.

PIN2		Somma
% + 5%) 34000 ±	(10% + 5%)	68000 ± (10% + 5%)
% +5%) 36000 ±	(15% +5%)	63000 ± (15% +5%)
% + 5%) 48000 ±	(10% + 5%)	94400 ± (10% + 5%)
	PIN2 % + 5%) 34000 ± % +5%) 36000 ± % + 5%) 48000 ±	PIN2 $4 + 5\%$ $34000 \pm (10\% + 5\%)$ $4 + 5\%$ $36000 \pm (15\% + 5\%)$ $48000 \pm (10\% + 5\%)$

Cristallo	PIN1	PIN2	Somma
311017	31000 ± (10% + 5%)	31000 ± (10% + 5%)	62000 ± (10% + 5%)
327017	29000 ± (10% +5%)	30000 ± (10% +5%)	55000 ± (10% +5%)
319065 (non irraggiato)	47800 ± (10% + 5%)	48000 ± (10% + 5%)	94400 ± (10% + 5%)

Cristallo	PIN1	PIN2	Somma
311017	25000 ± (10% + 5%)	25000 ± (10% + 5%)	50000 ± (10% + 5%)
327017	n/a	n/a	n/a
319065 (non irraggiato)	47800 ± (10% + 5%)	48000 ± (10% + 5%)	94400 ± (10% + 5%)

APD vs pin diode signal



- In this run:
 - Transimpedance amplifier
 - High APD bias voltage (gain>~250)

APD vs pin diode signal



Very high S/N for APDs

• TAPD=25ns Tpin=500ns

ENE in Csl(Tl) - B2GM June'16



Attività della sorgente ~ consistente con le (penultime) simulazioni





Come atteso non c'e' effetto nell'equivalent noise energy scorrelato, perche' la luce del pile-up e' vista in maniera correlata da entrambi i fotosensori



Relative resolution





9 novembre 2016

Non è chiaro che ci sia un vantaggio, anche a basse energie:

- APD+ampl. transimpedenza con tau=75ns:
 - ENE~1.3MeV, reso(stocastica)~4.5% ovvero δ E~2MeV @ 34 MeV, δ E~2.9MeV @ 100 MeV
- Pin diodes con tau=500ns:
 - ENE~2.2MeV, reso(stocastica)~2% ovvero δE~2.3MeV @ 34 MeV, δE~2.5MeV
 @ 100 MeV
 - Nota: dati presi con il cristallo **327017**, con la peggiore resa di luce: la fluttuazione stocastica è più alta ($\sim\sqrt{2}$?)
- Da valutare l'effetto sul cluster, e la combinazione APD + Pin diodes